RFT

VEB WERK FÜR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK

„Carl von Ossietzky"

Ossietzky-Werk Teltow, Potsdamer Str. 117—119

Herrn

Friedhelm Röthig
Görlitz /Sa.

Elisabethstr. 7

Ministerium für Allgemeinen Maschinenbau
Hauptverwaltung R-F-T
Fernruf: Teltow 621 — 625
Telegramm-Anschrift: Ossietzkywerk Teltow
Fernschreiber: Potsdam 015108
Betriebsnummer: 04/2518

TELTOW bei Berlin
Potsdamer Straße 117 — 119

Ihre Nachricht vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Hausapparat	Tag
19.10.1958		KA W/Pl.	261	30.10.1958

BETRIFFT: Prospektmaterial.

In Erledigung Ihrer Anfrage erlauben wir uns, Ihnen anliegend das von Ihnen gewünschte Prospektmaterial kostenlos zu übersenden.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Zusammenstellung Anregungen vermitteln wird und für Sie eine zweckmässige Arbeitsunterlage darstellt.

[illegible] zu richten.

Sollte weder die HO noch die Konsumgenossenschaft bisher einen Lieferungsvertrag mit uns abgeschlossen haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrer Bestellung an die DHZ Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik, Potsdam, Schopenhauer Str. 1, zu wenden. Bei diesen Bestellungen, die in Ihren Stückzahlen unterhalb der Mindestbestellmenge liegen, wird Ihnen der Preis von der DHZ genannt.

Anlagen:
Germanium-Dioden
Transistoren und
Flächengleichrichter.

VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik "Carl v. Ossietzky"

(Retzke)
Ltr. d. Abt. Absatz

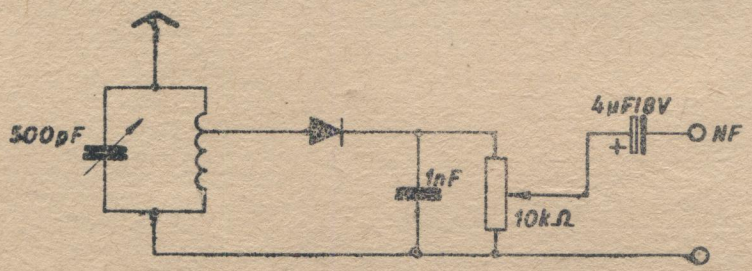
(Sauer)
Werbung u. Messen

RFT

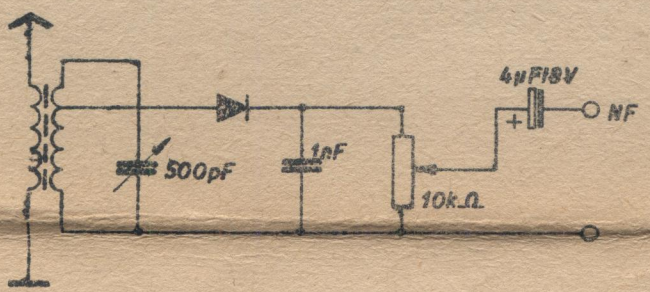
VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Diodengleichrichtung

Als Dioden können alle im Handel erhältlichen Typen verwendet werden (GDT Dioden)



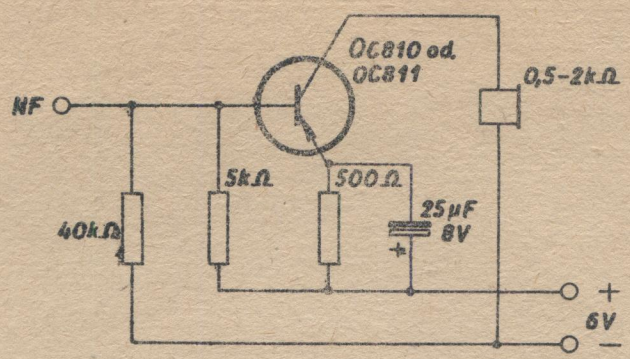
Bei Ferritstab ca. 50 Wdg.
Anzapfung bei ca. 10 Wdg.
Bei Topfkern ca. 80 Wdg.



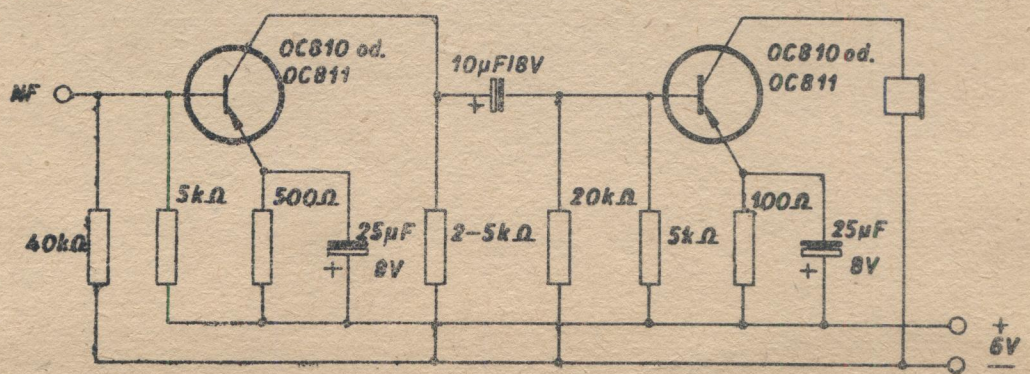
Bei Verwendung einer Hochantenne bietet diese Schaltung bessere Trennschärfe

NF-Verstärker für Kopfhörerbetrieb

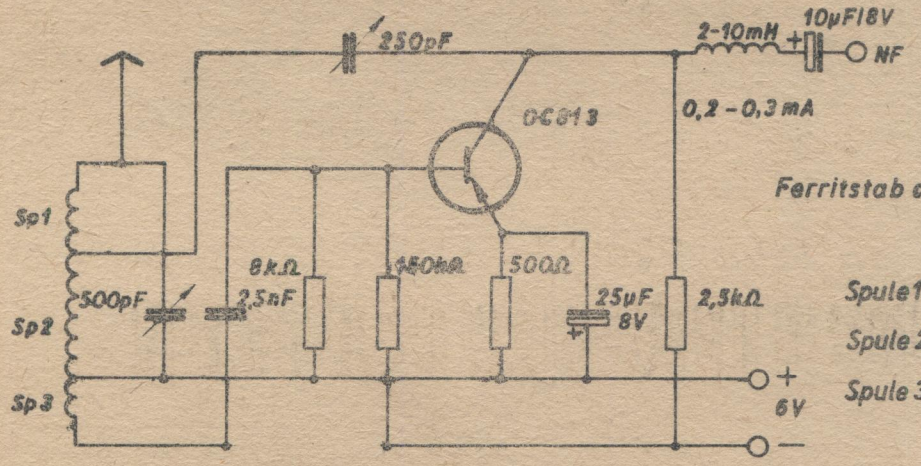
Einstufiger NF-Verstärker



Zweistufiger NF-Verstärker



Audion mit Ferritstab



Ferritstab ca. 10 x 120 – 200mm lg.

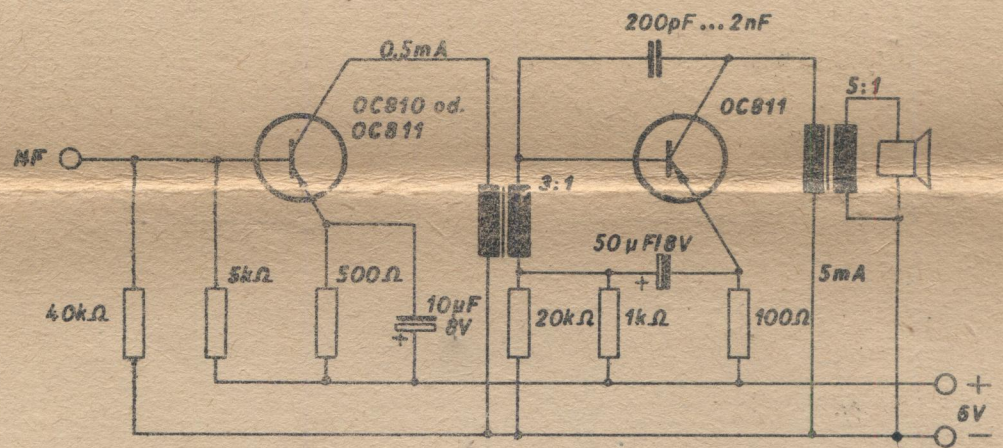
Mittelwelle

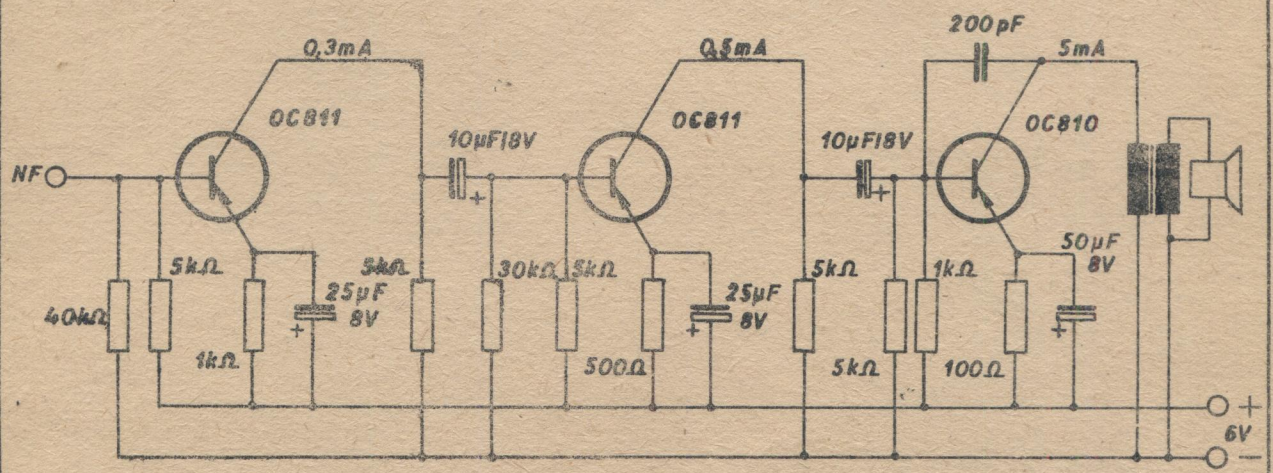
Spule 1: 50 Wdg. HF Litze

Spule 2: 15 Wdg. HF Litze

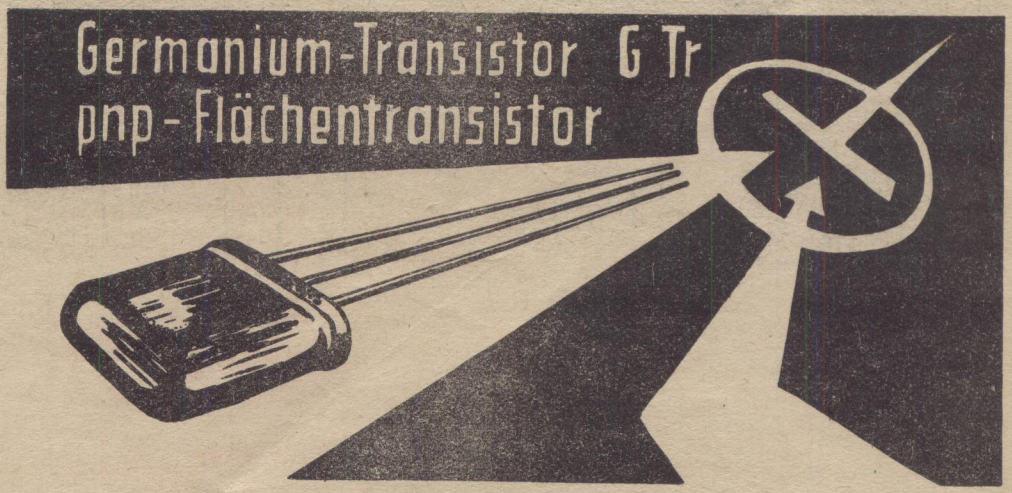
Spule 3: 10 Wdg. HF Litze

NF Verstärker für Lautsprecherbetrieb





FLÄCHENTRANSISTOREN



WBN Teltow

RFT

Verwendungszweck:

NF-Transistor kleiner Leistung für Lehrzwecke

Technische Daten:

(Umgebungstemperatur $\vartheta_a = 25\,°C$)

Kollektorreststrom bei $I_E = 0, -U_{CB} = 5\,V$ $I_{CO} \leqq 50$ /uA

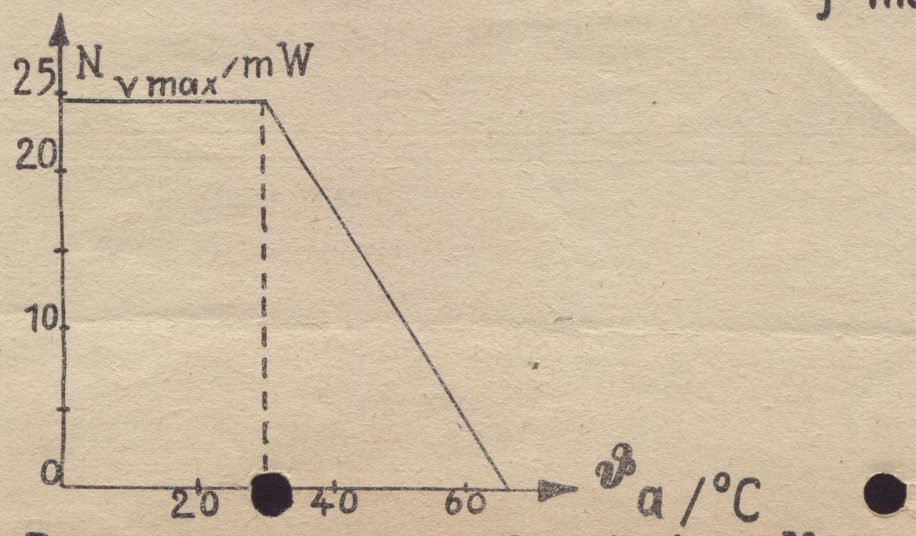
$I_B = 0, -U_{CE} = 5\,V,$ $I'_{CO} \leqq 800$ /uA

Kurzschluß-Stromverstärkung in Emitterschaltung $\alpha' \geqq 10$

Maximale Verlustleistung $N_{V\,max} = 25\,mW$

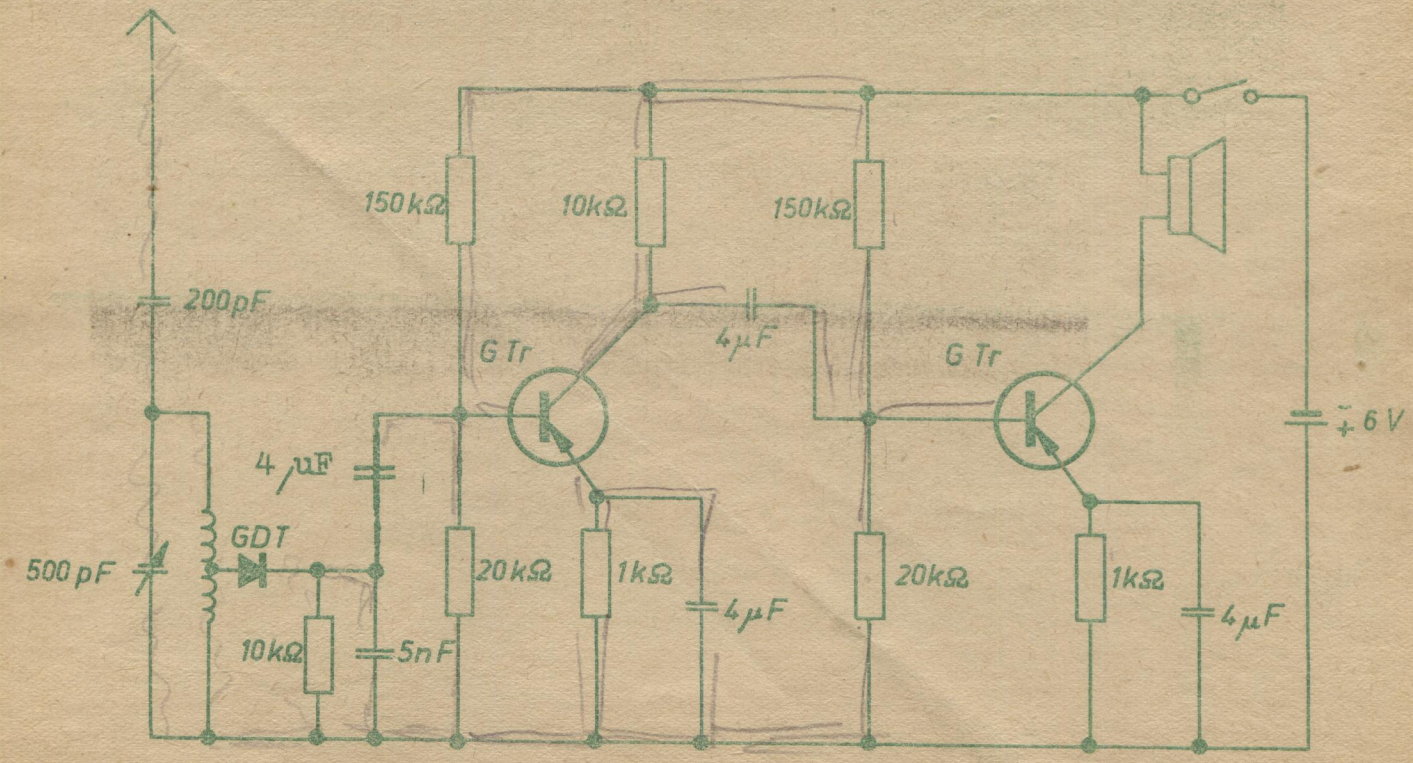
Maximaler Kollektorstrom $I_{C\,max} = 10\,mA$

Maximale Sperrschichttemperatur $\vartheta_{j\,max} = 65\,°C$

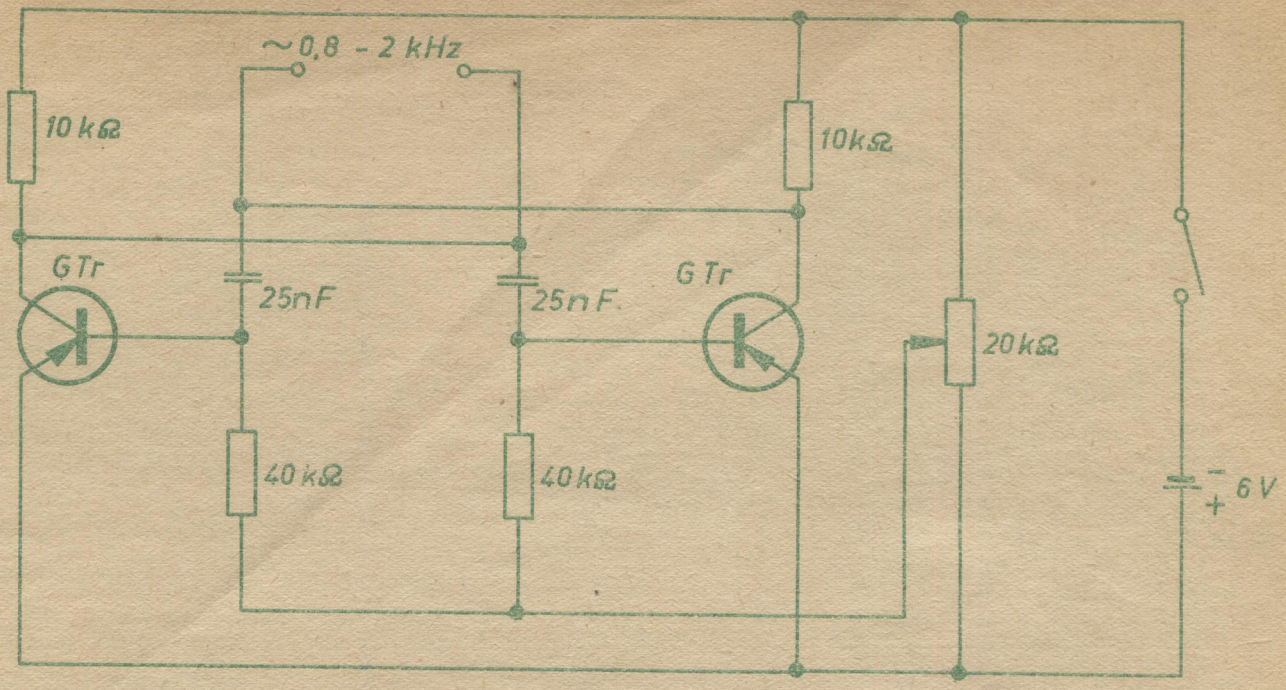


Reduktion der maximal zulässigen Verlustleistung

VEB WERK FÜR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK TELTOW



Diodenempfänger mit zweistufiger Transistorverstärkung

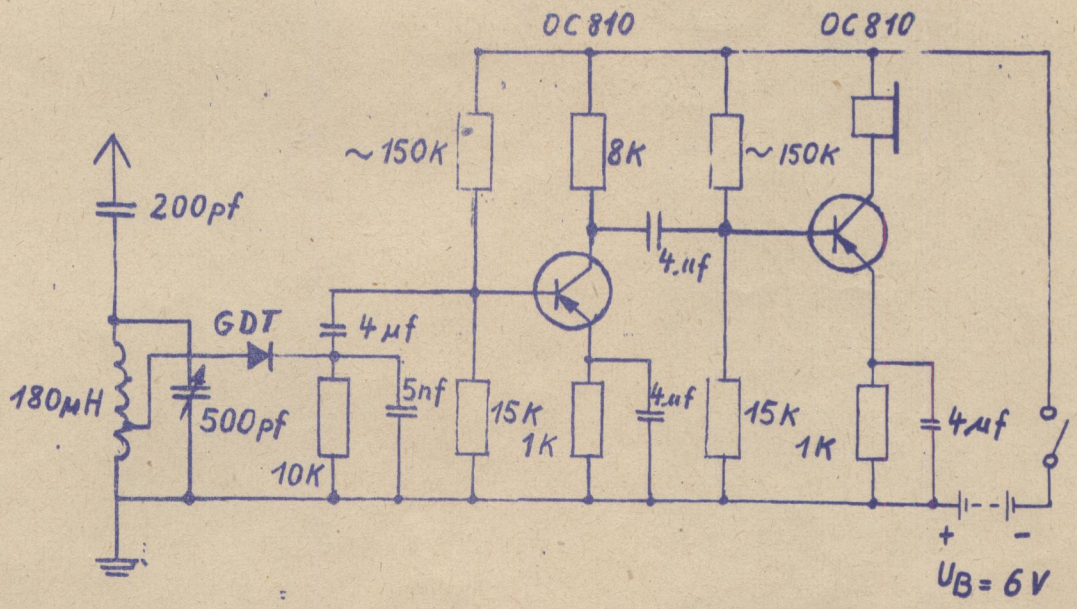


Regelbarer Multivibrator

F 449/58

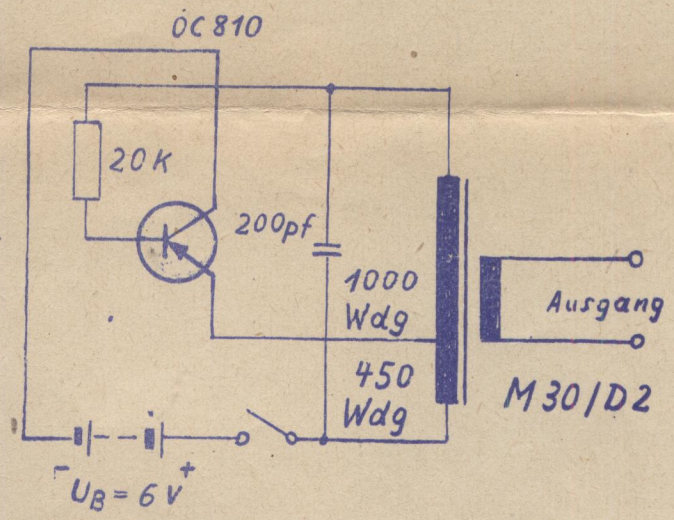
WBN 2/V 019 I/10/13 VEB (K) Stadtdruckerei Trebbin 823 Fl 640/58

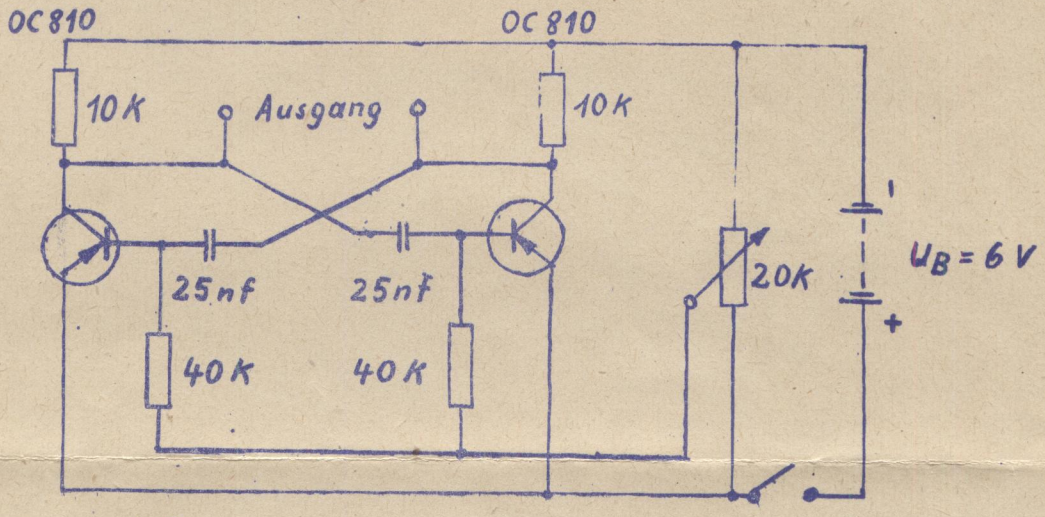
Schaltungsbeispiele mit Transistoren und Dioden



Diodenempfänger mit zweistufigem NF-Verstärker

NF-Generator
(~2 kHz)





Multivibrator (regelbar 800 Hz - 1,5 kHz)

VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik
„Carl von Ossietzky"
Teltow, Potsdamer Straße 117-119

WBN TELTOW

Einbau-Hinweise für Flächengleichrichter mit Schaltskizzen

Die Technik erfordert in immer grösserem Umfang den Einsatz von Halbleiterbauelementen. Dies wird vor allem durch die grundlegenden Vorteile wie kleine Abmessungen, kleines Gewicht und grösserer Wirkungsgrad der Bauelemente bestimmt. Aus diesen Gründen werden sie speziell dort eingesetzt, wo wenig Raum, kleine Speisespannungen bzw. Speiseleistungen zur Verfügung stehen und ein geringes Gewicht des Gerätes gefordert wird. Diese angeführten Punkte fallen vor allem bei transportablen Geräten besonders ins Gewicht.

Germanium-Flächengleichrichter für kleine Sperrspannungen

Diese Gleichrichter werden in zwei verschiedenen Bauformen für 0,1 A bzw. 1 A mit 20 V und 50 V Sperrspannungen mit der Typenbezeichnung OY 100, OY 101, OY 110 und OY 111 gebaut.

Die Daten der einzelnen Typen:

		OY 100	OY 101	OY 110	OY 111
max. Eingangswechselspannung in Einwegschaltung (bei reellem Lastwiderstand)	$U_{\sim}(V_{eff})$	15	35	15	35
Scheitelwert der Sperrspannung	U_{sp} (V)	20	50	20	50
max. entnehmbarer Gleichstrom (bei reellem Lastwiderstand)	$I_{=}(A_{eff})$	0,1	0,1	1	1
Scheitelwert des Durchlass-Stromes	I_d (A)	0,35	0,35	3	3
max. Spannungsabfall in Flussrichtung	U_d (V)	0,5	0,5	1	1

Die angegebenen Daten gelten für +20°C Umgebungstemperatur, bei reduzierter Belastung (Durchlaßstrom + 0,5%°C^{-1} , Sperrspannung - 2%°C^{-1}) beträgt die max. Umgebungstemperatur +50°C.

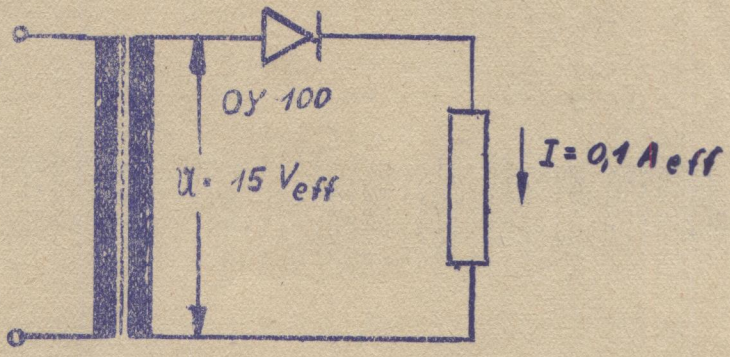
Die Typen OY 100 sowie OY 101 werden in der Bauform entsprechend Abb. 2 und OY 110 sowie OY 111 entsprechend Abb. 1 ausgeführt .

Die Bauform nach Abb. 2 muss auf eine Kühlfläche von mindestens 25 cm^2 geschraubt werden.

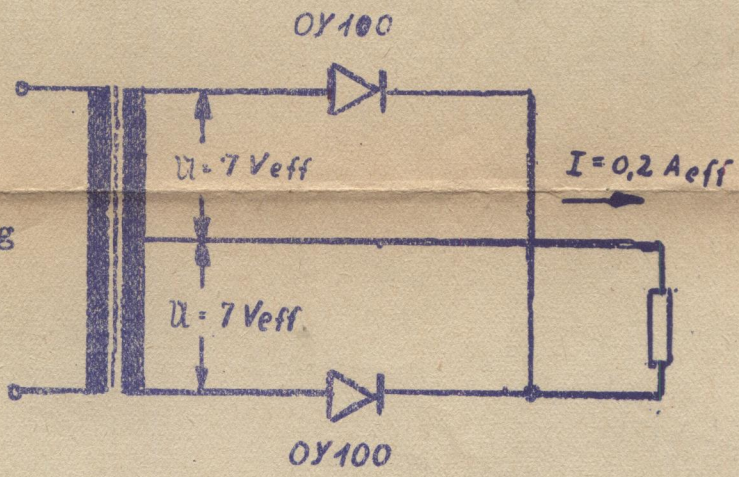
Diese Gleichrichter eignen sich vorzüglich für Ladegeräte zur Aufladung der verschiedensten Sammler oder zur Verwendung in Stromversorgungsgeräten. Bei der Dimensionierung der Schaltung ist zu beachten, dass die angegebenen Daten nur für reellen Lastwiderstand gelten. Bei kapazitiver Last ist die Änderung der am Gleichrichterelement anliegenden Sperrspannung wie beim Selengleichrichter zu berücksichtigen.

Schaltungsbeispiele mit Flächengleichrichter

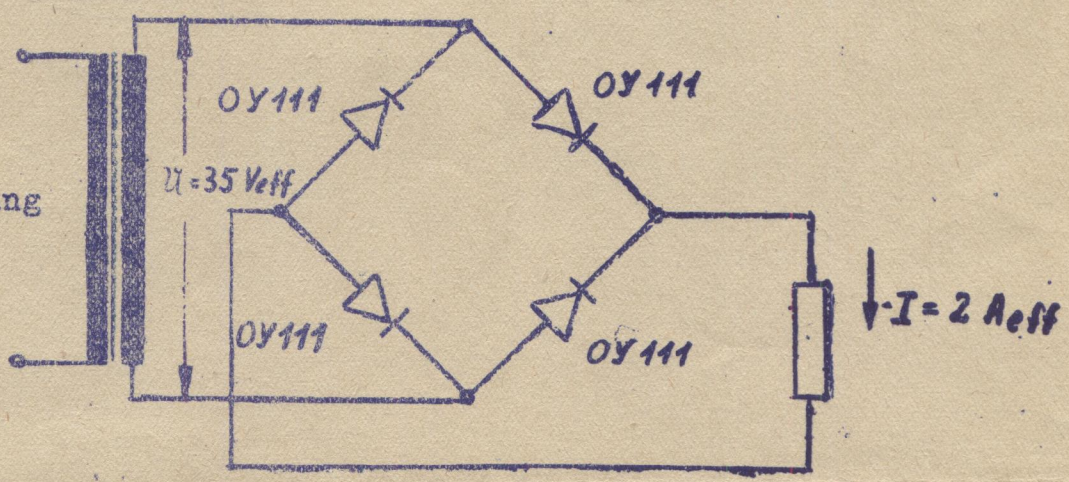
Einwegschaltung



Zweiweg-gleichrichtung



Graetzschaltung



Hinweise für den Bau von Empfängern mit Germanium-Detektoren

Der VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik »Carl von Ossietzky«, Teltow, hat ein neues Halbleiterbauelement, den Germaniumdetektor, herausgebracht. Dieser eignet sich sehr gut für einfache aber leistungsfähige Kopfhöreremp fänger. Die Schaltung eines solchen Kleinempfängers, der ohne Batterie betrieben werden kann, zeigt Abbildung 1. Bei einer Schwingkreisinduktivität von 0,16 mH und einem Abstimmdrehkondensator von 500 pF kann der Mittelwellenbereich überstrichen werden. Der zur Ableitung der Hochfrequenz vom Kopfhörer dienende Kondensator C hat eine Kapazität von 5000 pF. Bei einer guten Hochantenne und Erde kann man einen Großsender noch in einer Entfernung bis zu 45 km empfangen. In der Nähe von Großsendern genügt auch eine Behelfsantenne. Zur Erhöhung der Trennschärfe des Empfängers schaltet man die Diode zweckmäßig an eine Anzapfung der Schwingkreisspule an, da hierdurch der Schwingkreis weniger stark bedämpft wird. Die Anzapfung liegt bei etwa $^1/_6$ der Windungszahl vom erdseitigen Ende der Spule, wie dies Bild 2 zeigt. Eine weitere Erhöhung der Trennschärfe wird durch Bandfiltereingang nach Bild 3 erreicht. Mit dieser Schaltung wird wegen ihrer geringen Empfindlichkeit nur unter sehr günstigen Empfangsverhältnissen und einer sehr guten Hochantenne und guter Erde unmittelbar Kopfhöreremp fang möglich sein. Wegen ihrer hohen Wiedergabequalität eignet sich diese Schaltung - Abbildung 3 - besonders als Empfänger von einem Kraftverstärker mit hoher Wiedergabegüte.

Empfänger nach Schaltbild 1 und 2 eignen sich auch zum UKW-FM-Empfang bei entsprechender Dimensionierung des Schwingkreises. Man muß den Empfänger auf die Mitte einer Seitenflanke der Resonanzkurve einstellen, wie dies Bild 4 zeigt. Hierbei erfolgt Flankendemodulation. Auf Grund der geringen Empfindlichkeit dieser Anordnung ist Empfang jedoch nur in Sendernähe möglich.

VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik »Carl von Ossietzky«

Teltow bei Berlin - Potsdamer Straße 117-119 - Ruf: Teltow 621

VEB Halbleiterwerk
Frankfurt (Oder)
Frankfurt (Oder), Potsdamer Straße 1-2

I/16/7 F 346 57 446

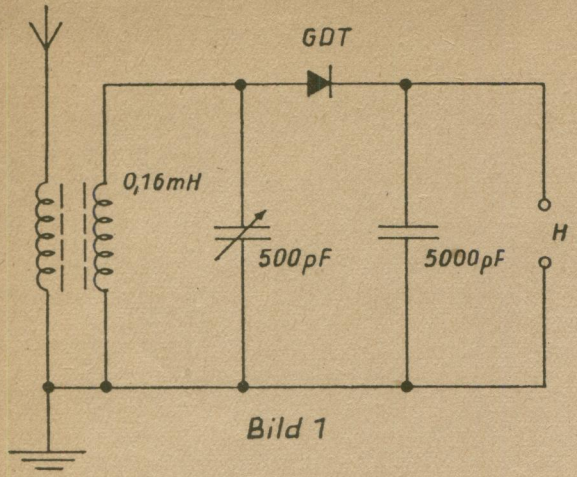


Bild 1

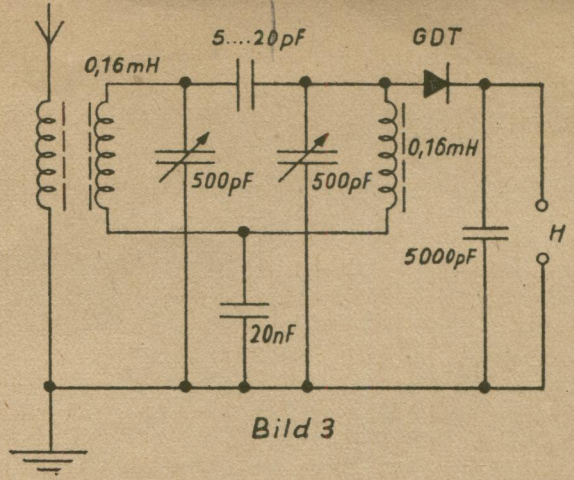


Bild 3

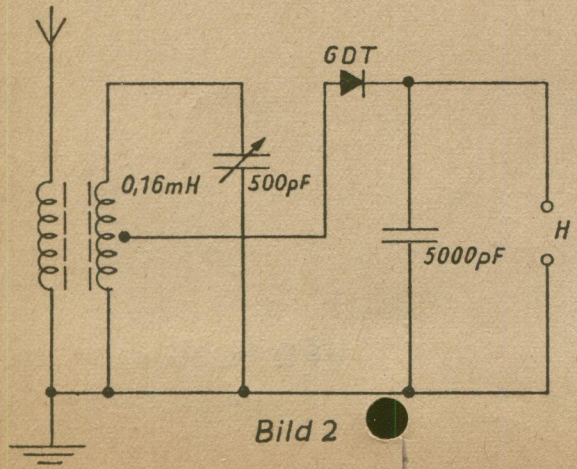


Bild 2

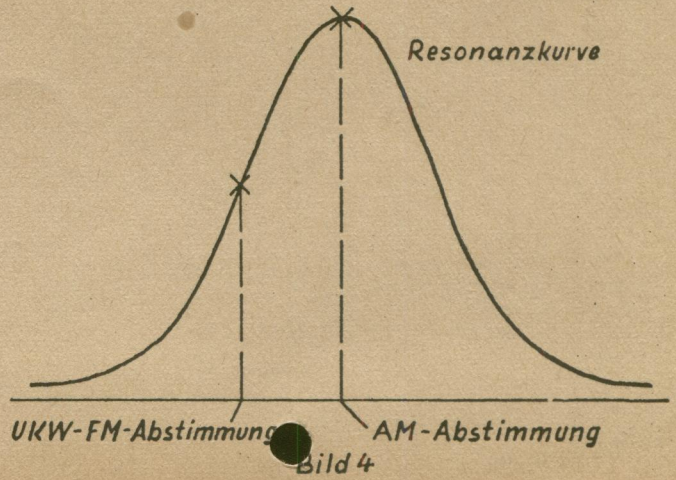


Bild 4